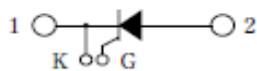


THYRISTOR

250A Avg 1600 Volts

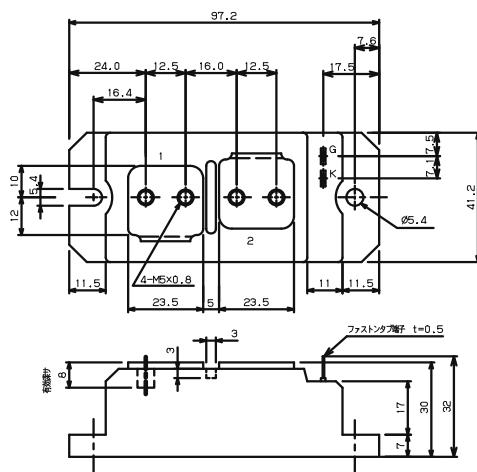
PHT25016

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



(注)アノードとカソード間の空間距離は5mmであり、UL1557,400V系にて使用される場合、十分な空間距離を満足させてください。

The striking distance between the anode and the cathode of this module is 5mm, filing with UL1557, but when used by the system of 400V AC, take an enough striking distance and wire.

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PHT25016	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V _{DRM}	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V _{D_{SM}}	1700	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{R_{RM}}	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{R_{S_M}}	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max.Rated Value	単位 Unit		
平均オン電流 Average On-State Current	$I_{O(AV)}$	商用周波数 180° 通電 Half Sine Wave	250	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	I_{TRMS}		390	A		
サーボン電流 Surge On-State Current	I_{TSM}	50Hz 正弦半波、1サイクル、非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A		
電流二乗時間積 I^2t	I^2t	2~10ms	80000	$A^2 s$		
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	$V_D=2/3 V_{DRM}$, $I_{IM}=2 \cdot I_O$, $T_j=125^\circ C$ $I_C=300mA$, $di/dt=0.2A/\mu s$	100	$A/\mu s$		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P_{GM}		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I_{GM}		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V_{GM}		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V_{RGM}		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{JW}		-40 ~ +125	°C		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{STG}		-40 ~ +125	°C		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V_{ISO}	端子-ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマルコナ® ウド塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N · m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ~ 2.8	N · m

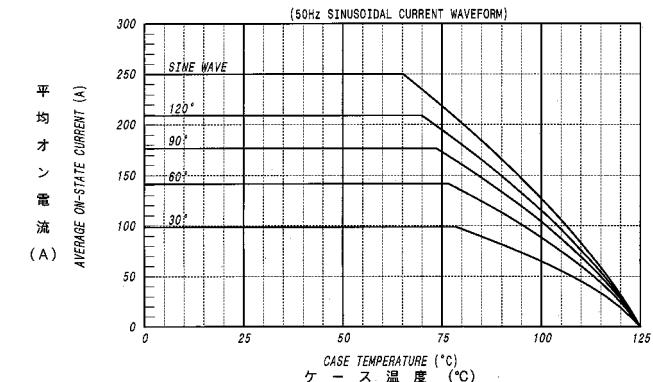
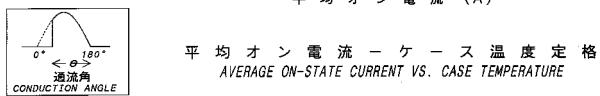
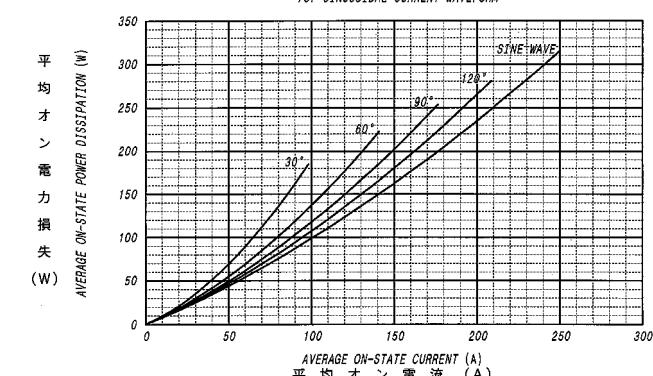
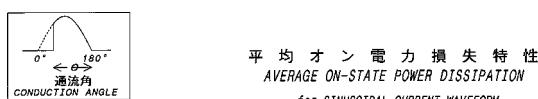
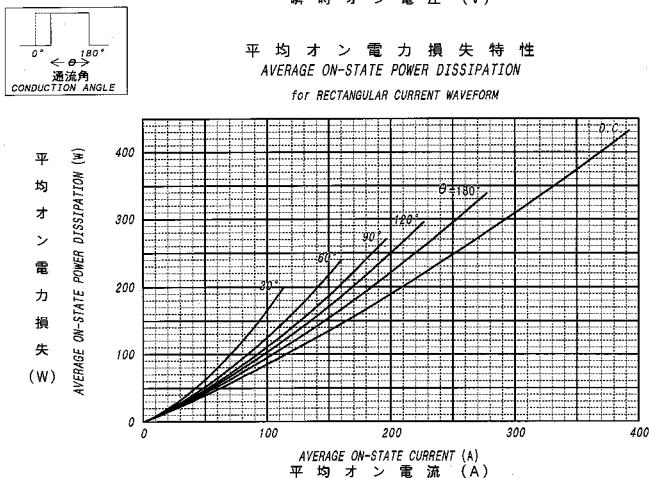
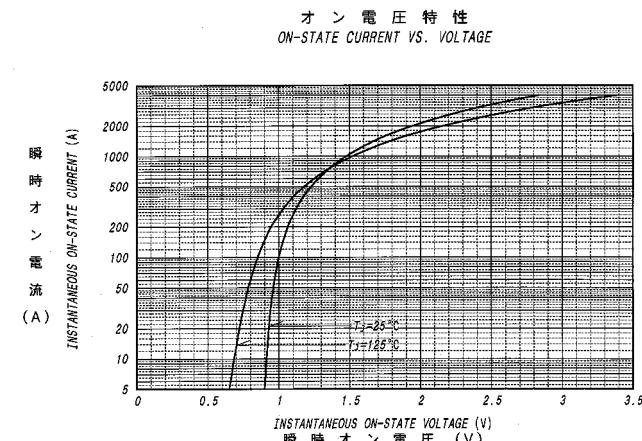
■電氣的特性 Electrical Characteristics

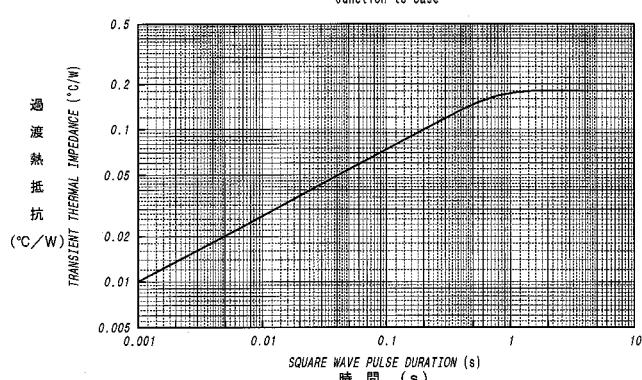
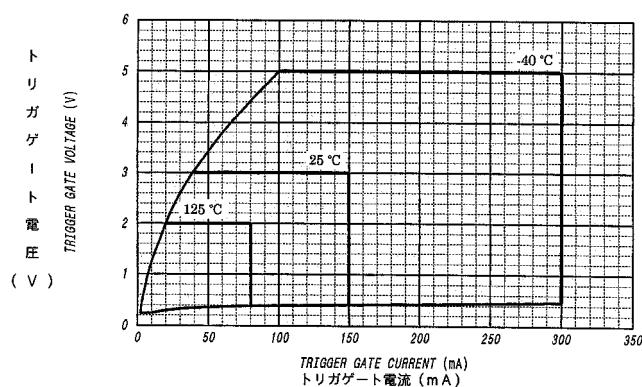
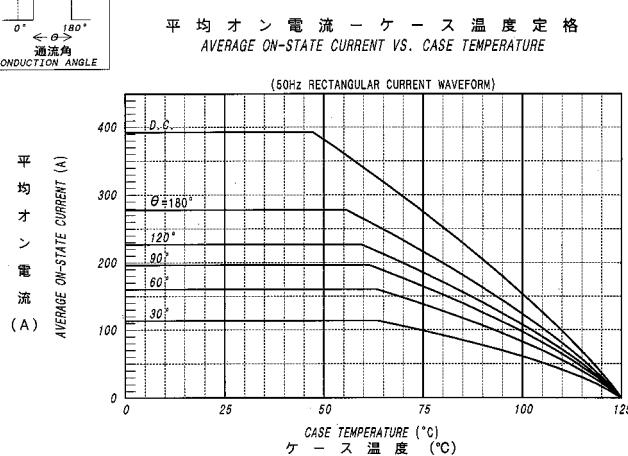
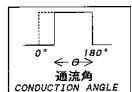
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit	
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.		
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	IDM	T _j =125°C, V _{DM} =V _{DRM}			80	mA	
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I _{RM}	T _j =125°C, V _{RM} =V _{RRM}			80	mA	
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	V _{TM}	T _j =25°C, I _{TM} =800A			1.38	V	
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D =6V, I _T =1A	T _j =-40°C		300	mA	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}		T _j = 25°C		150	mA	
			T _j = 125°C		80	mA	
			T _j =-40°C		5	V	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	V _D =6V, I _T =1A	T _j = 25°C		3	V	
			T _j = 125°C		2	V	
			T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM}	0.25		V	
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dV/dt	T _j =125°C, V _D =2/3V _{DRM}	500			V/μs	
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j =125°C, I _{TM} =I _O , V _D =2/3V _{DRM} dV/dt=20V/μs, V _R =100V, -di/dt=20A/μs	200			μs	
ターンオン時間 Turn-On Time	t _{gt}		6			μs	
遅れ時間 Delay Time	t _d		2			μs	
立ち上がり時間 Rise Time	t _r		4			μs	
ラッチング電流 Latching Current	I _L	T _j =25°C	150			mA	
保持電流 Holding Current	I _H	T _j =25°C	100			mA	
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部-ケース間 Junction to Case			0.18	°C/W	
接触熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(c-f)}	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.1	°C/W	

質量…約250g

Approximate Weight

■定格・特性曲線





サージオン 電流 定格
SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=125°C

